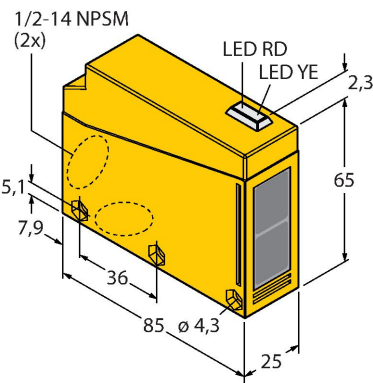


Q8562E-B

Фотоэлектрический датчик – оппозитный датчик (излучатель)



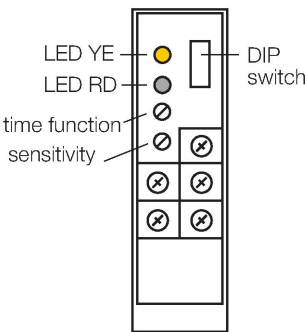
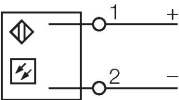
Технические характеристики

Тип	Q8562E-B
ID №	3034263
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передатчик
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Диапазон	0...23000 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...48 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 120 мА
Ток холостого хода	≤ 25 мА
Защита от обратной полярности	да
Задержка готовности	≤ 0 мс
Время отклика типовое	< 20 мс
Параметр настройки	Потенциометр
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, Q85
Размеры	85 x 65 x 25 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	акрил, Акрил
Электрическое подключение	Клеммный блок
Количество проводников	2
Температура окружающей среды	-25...+55 °C
Степень защиты	IP67

Свойства

- Встроенная клеммная коробка
- Кабельные сальники, смещенная установка на 90° в двух местах
- Степень защиты IP67
- Рабочее напряжение: 10...48 В DC

Схема подключения



Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из приемника и излучателя. Они устанавливаются оппозитно, так чтобы свет излучателя попадал непосредственно в приемник. Датчик переключается в случае прерывания или ослабления светового луча объектом. Оппозитные датчики - наиболее надежные фотоэлектрические датчики для определения непрозрачных объектов. Отличный контраст между светлыми и темными условиями и высокая чувствительность типичны для данного режима работы, что позволяет датчику работать в плохих условиях на дальние расстояния.

Запас по работоспособности
Зависимость работоспособности от расстояния

Технические характеристики

Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	

